









	<h2 style="color: red;">IPD068N10N3GBTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD068N10N3GBTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 90A TO252-3
	Datenblätter:	 IPD068N10N3GBTMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPD068N10N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 90A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4910pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD068N10N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD068N10N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD068N10N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD068N10N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD064N06N INFINEO IPD064N06N INFINEO	 IPD068N10N3 G INFINEON IPD068N10N3 G INFINEON	 IPD068P03L3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 70A TO252-3	 IPD060N03LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A TO252-3
 IPD068P03L3 G I IPD068P03L3 G I	 IPD068N10N3G infineon IPD068N10N3G infineon	 IPD068P03L3G I IPD068P03L3G I	 IPD068N10N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 90A

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD068N10N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD068N10N3GBTMA1 Datenblatt	IPD068N10N3GBTMA1-Datenblätter	IPD068N10N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD068N10N3GBTMA1
IPD068N10N3GBTMA1 Electronic	IPD068N10N3GBTMA1-Komponenten	IPD068N10N3GBTMA1-Verteiler	IPD068N10N3GBTMA1-Bild	IPD068N10N3GBTMA1-Teil
IPD068N10N3GBTMA1 Preis	IPD068N10N3GBTMA1 Hersteller	IPD068N10N3GBTMA1 Bild	IPD068N10N3GBTMA1 Aktie	IPD068N10N3GBTMA1 Inventar
IPD068N10N3GBTMA1 Neu	IPD068N10N3GBTMA1 Original	IPD068N10N3GBTMA1 garantiert	IPD068N10N3GBTMA1 RFQ	IPD068N10N3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited